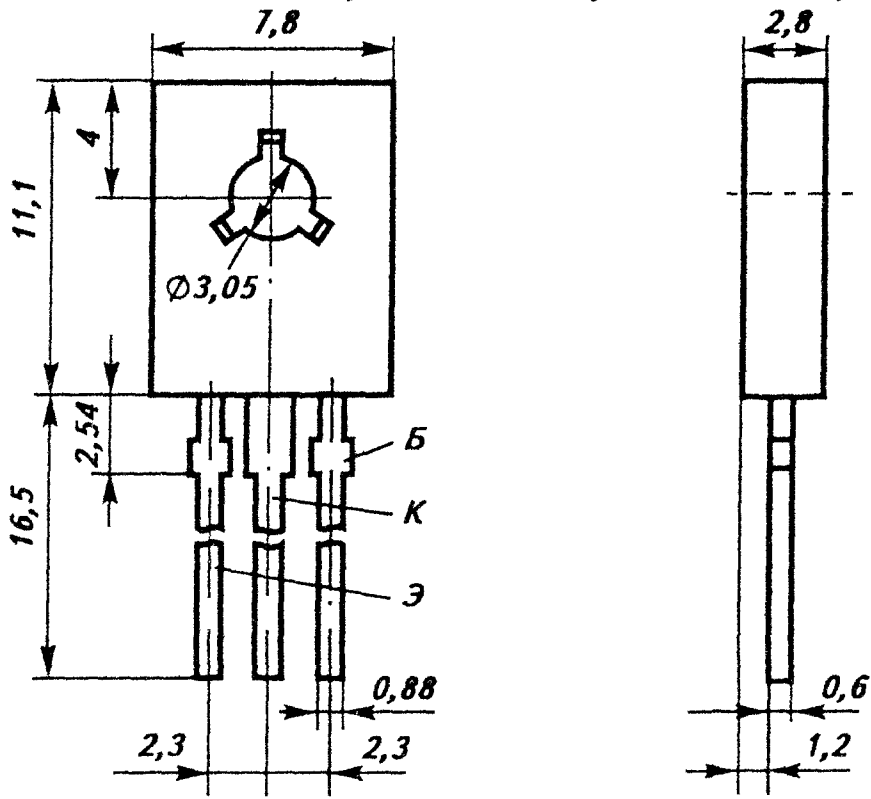


□ **КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е.**



КТ683(А-Е)

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 1 г.

**Электрические параметры**

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ} = 10$  В,

$I_{к} = 0,15$  А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г .....	40..120
КТ683Б, КТ683Д .....	80...240
КТ683Е .....	160..480

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кб} = 10$  В,

$I_{э} = 50$  мА,

не менее .....	50 МГц
----------------	--------

Граничное напряжение при  $I_{э} = 30$  мА, не менее

КТ683А .....	90 В
КТ683Б, КТ683В .....	80 В
КТ683Г .....	60 В
КТ683Д, КТ683Е .....	40 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_{к} = 0,15$  А,  $I_{б} = 15$  мА,

не более .....	0,45 В
----------------	--------

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_{к} = 0,15$  А,  $I_{б} = 15$  мА,

не более .....	1 В
----------------	-----

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при  $I_{к} = 0,1$  мА,  $R_{бэ} = 3$  кОм,

не менее:	
КТ683А .....	150 В
КТ683Б, КТ683В .....	120 В
КТ683Г .....	100 В
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В

Пробивное напряжение база-эмиттер при  $I_{э} = 0,1$  мА, не менее

КТ683А, КТ683Б, КТ683В .....	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е .....	5 В

Время включения при  $U_{кб} = 40$  В,  $I_{к} = 0,2$  А,  $I_{б} = 40$  мА,

типичное значение .....	0,1* мкс
-------------------------	----------

Время выключения при  $U_{кб} = 40$  В,  $I_{к} = 0,2$  А,  $I_{б} = 40$  мА,

типичное значение .....	0,2* мкс
-------------------------	----------

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 10$  В, не более

.....	15* пФ
-------	--------

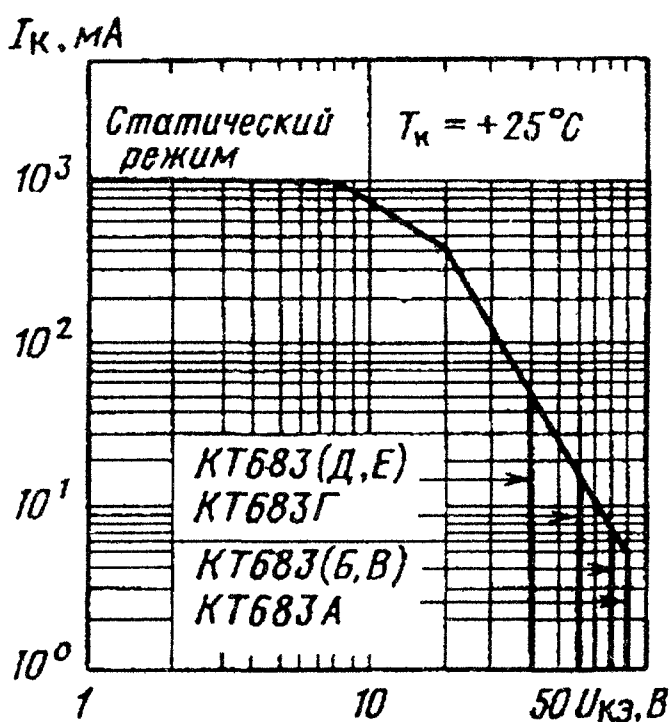
Емкость эмиттерного перехода при  $U_{эб} = 0,5$  В, не более

.....	65* пФ
-------	--------

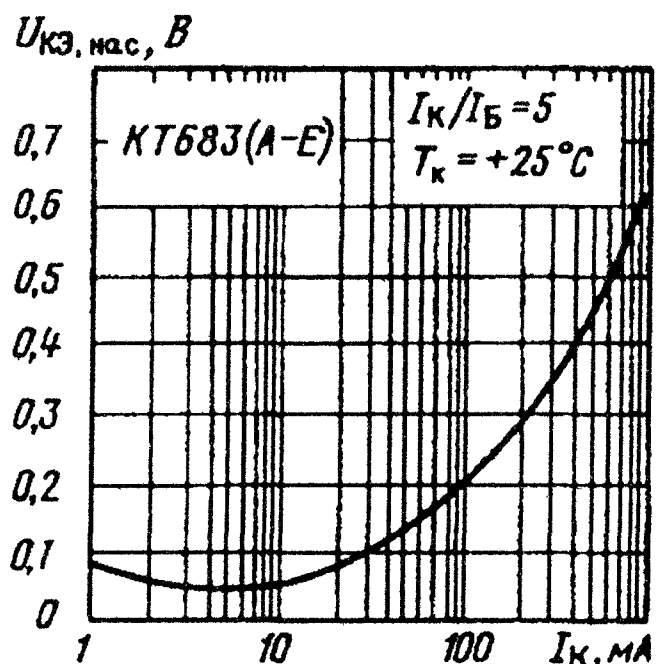
Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 90$  В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В

и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более .....

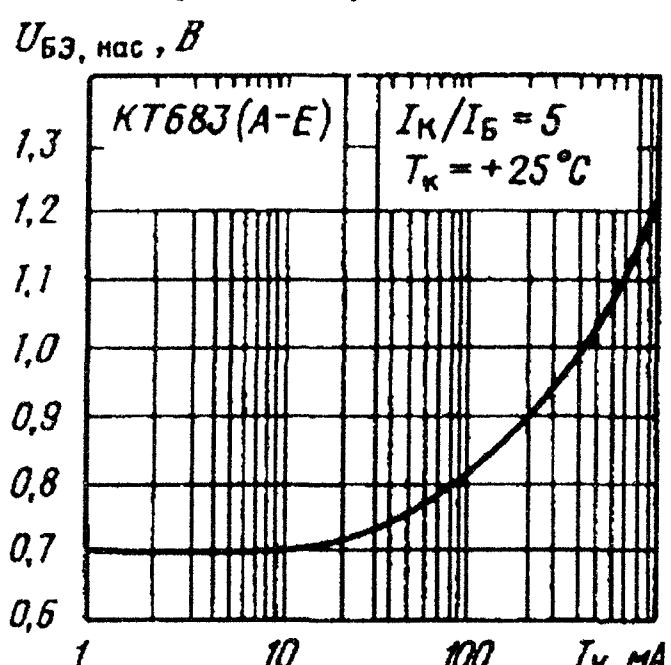
1 мкА



Области безопасной работы транзисторов



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора